FOR USE BY ELECTRICIANS OVERSEAS:

最新トランジスタ規格表 (New Transistor Manual) lists all the transistors registered with the Electronic Industries Association of Japan (EIAJ), arranged in a manner easy to look up. We hope that you will make full use of the data provided in this manual by referring to the Japanese-English translation key given below.

型名	社名	用途	構造	最大定格 (Ta=25°C)					電気的特性 (Ta=25°C)												外形	備考
				V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	I_{CBO}最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流又はパルスh_{FE} V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μ℧)	$f_{\alpha b}$ f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)		
1	2	3	4	5					6		7		8						9	10	11	12

1 TYPE NUMBER

2 ORIGINAL MANUFACTURER

3 USES

4 MATERIAL AND STRUCTURE

5 MAXIMUM RATINGS

6 I_{CBO} MAXIMUM VALUE AND V_{CB} VALUE (CRITERIA FOR MEASURING I_{CBO})

7 STANDARD VALUE OF DC/PULSE h_{FE} AND V_{CE} , I_C (CRITERIA FOR MEASURING DC/PULSE h_{FE})

8 STANDARD VALUE OF h PARAMETERS AND BIAS V_{CB} , I_E (CRITERIA FOR MEASURING h PARAMETERS)

* INDICATES VALUE IN GROUNDED-BASE OPERATION, OTHERWISE VALUE IN EMITTER-GROUNDED OPERATION.

9 $f_{\alpha b}$ OF RF CHARACTERISTIC, EXCEPT IN CASE OF * WHICH INDICATES VALUE OF f_T.

10 C_{ob} AND $r_{bb'}$ OF RF CHARACTERISTICS EXCEPT IN CASE OF * IN $r_{bb'}$ COLUMN WHICH INDICATES VALUE OF h_{ie} (real)

11 OUTLINE

12 REMARKS

: とコンプリ : COMPLEMENTARY TO ·····

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流又はパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μ℧)	$f_{\alpha b}$ f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SC1361	ソニー	RF.LN	Si.PaMe	25	6	200	320	100	0.2	25	200	3	1	6	−0.1		36k	2.4	3.3	140*	4.5	$C_c r_{bb'}$ 350pS	138	
〃 1362	〃	〃	〃	50	6	200	320	100	0.2	25	200	3	1	6	−0.1		36k	2.4	3.3	140*	4.5	$C_c r_{bb'}$ 350pS	138	
〃 1363	〃	RF	〃	25	6	200	320	100	0.2	25	200	3	1	6	−2					140*	4.5	$C_c r_{bb'}$ 350pS	138	
〃 1364	〃	〃	Si.PaMe	50	6	200	320	120	0.2	25	200	3	1	6	−2	h_{fe} = 3 dB (f=100MHz)				140*	4.5	$C_c r_{bb'}$ 300pS	138	
〃 1365	日電	〃	Si.E	45	3	300	800	200	0.5	20	80	15	50	15	−70	G_p=17dB (f=200MHz)				1700*	NF=3 dB (f=200MHz)		84B	
〃 1366	〃	〃	〃	45	3	300	800	200	0.5	20	80	10	50	15	−50	G_p=18dB (f=200MHz)				2000*	NF=3 dB (f=200MHz)		84B	
★ 〃 1367	日立	PA	Si.TMe	1000	5	1 A	50W (Tc=25°C)	125	10	500	45	10	200	15	−200					6*	60	25	102	
〃 1368	〃	〃	Si.EPa	25	5	2.5A	8W (Tc=25°C)	150	20	25	60~320	2	500	2	−200					180*	30		160	2SA738とコンプリ
〃 1369																								
〃 1370																								
〃 1371																								
★ 〃 1372	富士通	RF.SW	Si.EP	30	5	200	200	125	0.5	10	100	1	10	6	−2					250*	4	80*	138	
〃 1373	日立	SW	〃	25	4	100	300	175	1	20	90	4	35			t_{on}<100nS, t_{off}<325nS t_{stg}<290nS							49C	
〃 1374	〃	〃	〃	25	4	100	300	175	0.25	20	>30	1	70			t_r<7nS, t_f<6nS t_{stg}<12nS							49C	
〃 1375	〃	〃	〃	25	4	100	300	175	0.05	5	>54	0.4	50			t_{on}<45nS, t_{off}<60nS							49C	
〃 1376	〃	〃	〃	40	4	500	300	175	I_{CES} 0.5	20	65	1	150	10	−30	t_{on}<25nS, t_{off}<25nS				590*	2.7		49C	
★ 〃 1377	東芝	PA	Si.E	90	4	6 A	20W (Tc=25°C)	150	10	60	>20	5	1 A	5	−200	P_o>8 W (f=27MHz, Vcc=12V, Pi=1W)				100*	60		268	
★ 〃 1378	〃	〃	〃	40	4	4 A	35W (Tc=25°C)	175	100	15	>10	5	10A	10	−200	P_o=25W (f=175MHz, Vcc=13.5V, Pi=6W)				150*	65	2*	135	
★ 〃 1379	〃	〃	〃	40	4	7 A	70W (Tc=25°C)	175	100	15	>10	5	1 A	10	−200	P_o=40W (f=175MHz, Vcc=13.5V, Pi=12W)				150*	130	1*	193	
〃 1380	〃	RF	〃	55	5	100	200	150	0.1	18	200~700	6	2	6	−1					80*	6		49C	
〃 1381	〃	RF.PA	〃	100	5	1 A	800	150	1	30	70~240	2	150	2	−150					50*	20	10	342	
〃 1382	〃	〃	〃	80	5	750	800	150	0.1	30	70~240	2	150	2	−150					100*	15		342	2SA682とコンプリ
〃 1383	松下	PA	Si.EP	30	5	1 A	750	135	0.1	20	160	10	500	10	−50					200*	11	3.5*	165	2SA683とコンプリ
〃 1384	〃	〃	〃	60	5	1 A	750	135	0.1	20	160	10	500	10	−50					200*	11	3.5*	165	2SA684とコンプリ
〃 1385	日立	SW	〃	60	5	500	800	175	0.5	30	>35	1.1	300			t_{on}<40nS, t_{off}<60nS							123	
〃 1386	〃	〃	〃	70	5	1 A	800	175	100	60	>30	1	60		30	t_{on}<30nS, t_{off}<55nS							123	
〃 1387	富士通	RF	〃	25	3	150	600	150	0.5	20	100	10	40	10	−40					1600*	2.5	40*	84B	
〃 1388	〃	SW	〃	100	6	1 A	800	200	0.5	70	>15	3	500			t_{on}<50nS, t_{off}<110nS t_{stg}<80nS							84C	
〃 1389																								
〃 1390																								